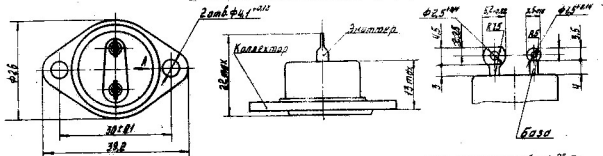




ПАСПОРТ

ТРАНСИСТОР СЛАБОГО ИМПЕДИСА П-Р-П ТИПА ТН-235-63

СОДЕРЖИТ ТИПОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СЕРИИ ТН-235-63



Масса транзистора не более 25 г.
В одном транзисторе содержится
0,0000125 г. золота и 0,0013 г. серебра.

1. Транзисторы по максимально допустимому напряжению коллектор-база делаются на классы.

Класс	Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база, В.		Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер при токе базы равном нулю.		Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер при заданных значениях соотношения в цепи база-эмиттер $\approx 3,4$ ом.		Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер, при заданном обратном напряжении эмиттер-база 3 В.	
	$U_{кб0}$	В.	$U_{ке0}$	В.	$U_{кэВ}$	В.	$U_{кэИ}$	В.
0,5	50		30		45		45	
1,0	100		60		90		90	
1,5	150		90		135		135	
2,0	200		120		180		180	
2,5	250		150		225		225	
3,0	300		180		270		270	
3,5	350		210		315		315	
4,0	400		240		360		360	
5,0	500		300		450		450	
6,0	600		360		540		540	

2. Транзисторы по напряжению наемнения коллектор-эмиттер делаются на группы.

Обозначение группы	Класс	Напряжение наемнения коллектор-эмиттер, В, не более:
1	0,5 - 2,0	0,6
2	0,5 - 6,0	1,5
3	0,5 - 6,0	2,0

3. Основные параметры.

Наименование параметра и режим измерения	Обозначение	Класс	Норма	
			Не менее	Не более
1. Максимально допустимый импульсный ток коллектора при температуре корпуса $+85^{\circ}\text{C}$, $r_{\text{к}} = 10$ Ом, скважность 2,	$I_{\text{кmax}}$	Все классы		50
2. Статический коэффициент передачи тока, при $I_{\text{к}} = 25$ А, $U_{\text{кб}} = 5$ В	$\beta_{\text{ст}}$	0,5-2,0	10	100
		2,5-6,0	8	100
3. Напряжение наемнения коллектор-эмиттер, при $I_{\text{к}} = 25$ А, $I_{\text{б}} = 4$ А, В	$U_{\text{кэнас}}$	0,5-6,0		2
	$U_{\text{кэИ}}$	0,5-2,0		0,35
4. Время выключения, при $I_{\text{к}} = 25$ А, $I_{\text{б}} = 4$ А, $U_{\text{кб}} \leq U_{\text{кб0}}$, $r_{\text{кб}} = 10$ Ом	$t_{\text{выкл}}$	2,5-6,0		1,00
		0,5-2,0		1,00
5. Время включения, при $I_{\text{к}} = 25$ А, $I_{\text{б}} = 4$ А, $U_{\text{кб}} \leq U_{\text{кб0}}$, $r_{\text{кб}} = 10$ Ом	$t_{\text{вкл}}$	2,5-6,0		3,00
		0,5-2,0		10
6. Обратный ток коллектор-база, при $U_{\text{кб}} = U_{\text{кб0}}$, мА	$I_{\text{кб0}}$	0,5-6,0		150
	$I_{\text{кбВ}}$	0,5-6,0		0,7
7. Обратный ток эмиттера, при $U_{\text{кб}} = 4$ В, мА	$I_{\text{э0}}$	0,5-6,0		
8. Тепловое сопротивление переход-корпус, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	$R_{\text{тк-к}}$	0,5-6,0		

4. Предельные допустимые эксплуатационные параметры

Наименование параметра	Обозначение	Класс	Допустимые значения параметра
1. Максимально допустимый постоянный ток коллектора, при температуре корпуса +25°C, $I_{кв.макс}$ = 0,2 $I_{кв.макс}$ А	$I_{кв.макс}$	Все классы	40
2. Максимально допустимый постоянный ток базы, А	$I_{б.макс}$	Все классы	13
3. Максимально допустимый импульсный ток базы, А	$I_{бв.макс}$	Все классы	16
4. Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{эб.макс}$	0,5-2,0	4
5. Максимально допустимая температура перехода, °C	T_{max}	2,5-5,0 Все классы	6 150

5. Условия хранения транзистора

Интервал температур от - 50°C до + 60°C

Относительная влажность воздуха 90% при 27°C

6. Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода транзистора в эксплуатацию.

Срок хранения - 3 года.

7. Указания и рекомендации по эксплуатации

Крепление транзисторов осуществляется при помощи крепежных фланца корпуса и теплоотводу с ушками с помощью винтов не менее 0,4 мм ± 0,05, деформация фланца не допускается.

Ножки транзистора должны обеспечивать надежный электрический и тепловой контакт между токопроводящими выводами или ножками аппаратуры, а также тепловой контакт между основанием транзистора и охлаждающим. Запрещается кручение выводов вокруг осей. При включении транзистора в схему, выходящую под напряжением, базовый вывод присоединяется первым и отключается последним.

В процессе работы транзисторов запрещается превышать предельно допустимые значения тока, напряжения и мощности, использовать транзистор в каких-либо солевых или других предельных режимах.

При работе транзисторов рекомендуется применять меры, обеспечивающие минимальную температуру корпуса, например, за счет рационального размещения транзисторов в блоках аппаратуры.

31. 03. 86г.

Подпись: _____
Имя ОТК

8. РЕКОМЕНДАЦИЯ

В случае предварительного выхода транзистора из строя, возвратить транзистор предприятию-изготовителю с указанием следующих данных:

Время хранения _____

Общее число часов работы транзистора _____

Основные данные режима эксплуатации _____

Причиной отказа транзистора с эксплуатации или хранения _____

Сведения заказчика _____

ВНИМАНИЕ!

ОТК просит по окончании эксплуатации транзисторов возвратить заводской паспорт предприятия-изготовителя.